鉄多価イオン分光用小型イオン源の製作と評価

量子·物質工学専攻 中村信行研究室 菊池浩行

1. 背景

多価イオンとは2価以上のイオンのことを言い、 取り去る電子がq個のとき、これをq価の多価イ オンと呼ぶ。

太陽観測衛星「ひので」[1]に搭載されている極 端紫外線撮像分光装置(EUV Imaging Spectrome ter: EIS)は太陽コロナに含まれる 10 価程度の鉄 多価イオンの分光診断により、コロナ加熱機構を 解明することを目的としている。図 1 に太陽大気 の温度と電子密度の様子を示す[2]。



図1.太陽大気の温度と電子密度の様子

通常このような分光診断は電子衝突断面積などの 基礎原子データに基づいたモデル計算との比較に より行われるが、鉄多価イオンの原子データにお いて信頼できる実験データは不十分であり、計算 値に頼っているのが現状である。そこで我々の研 究室では電子ビームイオントラップ(Electron Be am Ion Trap:EBIT)を用いて得られる実験室スペ クトルによりそれらの実験データを収集し、モデ ル計算の精度を向上させることを目的としている。

2. 電子ビームイオントラップ

(Electron Beam Ion Trap : EBIT)

電子ビームイオントラップ EBIT[3]は多価イオンの分光測定を目的として開発された。図 2 に EBIT での多価イオン生成原理図を示す。



図 2. EBIT の多価イオン生成原理図

EBITは大きく分けて電子銃、ドリフトチューブ (Drift Tube: DT)、電子コレクターの3つから成る (図2(a))。またDT の周りにはヘルムホルツ型超電 導コイルを配置し、軸方向の強磁場(図2(c))を形 成する。電子銃から出射した電子ビームは図2(b) のような電位配置によって加速され、磁力線に沿 って動径方向に圧縮されながらDTに入射する。中 央のドリフトチューブ電極(DT2)の電位を両極 (DT1、DT3)より低くして、そこで生成された イオンを軸方向に封じ込める。また高密度電子ビ ームの空間電荷によりイオンは径方向にも閉じ込 められる。こうしてDT2内部に閉じ込められたイ オンが電子の逐次衝突を受け、電離が進み多価イ オンが生成される。DTを通過した電子は電子コレ クターで発散し回収される。EBITは単色電子ビー ムとトラップ多価イオンから成る非常に単純化さ れたプラズマ光源であり、多価イオンの基礎原子 データの収集には最適の装置である。

3. EBIT における多価イオンの生成原理

3.1 逐次電離

逐次電離とは電子を1つずつ順番に電離してい くことである。電子ビームに束縛されたイオンは 連続的に電子ビーム衝撃を受け、

$$A + e^{-} \rightarrow A^{+} + 2e^{-}$$
$$A^{+} + e^{-} \rightarrow A^{2+} + 2e^{-}$$
$$\dots$$

$A^{(q-1)+} + e^- \rightarrow A^{q+} + 2e^-$

のように電子が1つずつ剥がれて多価イオンとなっていく。電子ビームの閉じ込めが完全で、逐次 電離のみが起こると考えた場合、イオン化の進行 は次の連立微分方程式で表される[4]。

$$\frac{dn_q}{d\tau} = n_{q-1}\sigma_i(q-1,q) - n_q\sigma_i(q,q+1)$$

ここで、 _i(q-1,q)は q-1 価イオンが q 価に成る時 の電離断面積、n_q は q 価イオンの数密度である。

は Ionization factor と呼ばれる量で、電子ビー ムの電流密度 J とイオンが電子ビーム衝撃を受け る時間 t を用いて =Jt/e と定義される。

3.2 イオンの閉じ込め

EBIT では DT の電位配置によるビーム軸方向 の閉じ込め、コイル磁場により圧縮された電子ビ ームの空間電荷による動径方向の閉じ込めを行う。 電子ビームの作る動径ポテンシャル V(r)は次式に より計算することができる。

$$V_{(r)} = \begin{cases} V_0 \left(\frac{r}{r_e}\right)^2 & (r \le r_e) \\ V_0 \left(1 + 2\ln\frac{r}{r_e}\right) & (r \ge r_e) \end{cases}$$
$$V_0 = V(r_0) = \pi e n_e r_e^2 = \sqrt{\frac{m_e}{2}} \frac{I_e}{\sqrt{E_e}}$$

V(r)は電子ビーム中心軸の電位を0Vとした時の軸 からの距離rでの電位を示している。reは電子ビ ーム半径、eは素電荷、neは電子ビーム断面の電 子密度、me,Ie,Eeはそれぞれ電子の質量、電子 ビーム電流、電子ビームエネルギーを示す。この 式から電子ビーム内のポテンシャルの深さ、つま り電子ビーム内に閉じ込める力は、電子ビームエ ネルギーの平方根に逆比例し、同電流に比例する ことがわかる。

3.2 電子ビームの圧縮

EBIT において高効率に電離を行うには電子密 度の高い電子ビームを形成することが非常に重要 であり、そのため磁場により電子ビームを細くす る必要がある。磁場が完全に遮蔽された理想的な 陰極面から初速度ゼロ(温度 T=0K)で放出された 電子ビームは軸方向の磁場 Bによりビーム半径 r_B まで圧縮される。



ここで 0は真空中の誘電率、Bzは磁場の軸方向成分を示す。

3.3 価数分布

3.1 では理想的な逐次電離を考えたが、実際には 残留ガスとの衝突や放射性再結合(radiative reco mbination)による電子捕獲が起こるため、生成さ れるイオンの価数は逐次電離によるイオン化と電 子捕獲との競合で決まる。そのため、3.1の逐次電 離の式に、これら2つの影響による電子捕獲の項 を付け加えて考えなければならない。しかし、本 研究のように生成する多価イオンの価数がそれほ ど高くない場合、放射性結合の割合はイオン化の 割合に比べてとても小さいため無視することがで きる[5]。残留ガスとの衝突による電子捕獲により q価のイオンがq-1価のイオンになるときの電子捕 獲断面積を ₍(q, q 1)とおき、与えられた電子 ビームエネルギーで到達する最高価数が q 価とす ると、平衡に達したときの価数分布は以下のよう になる。

$\frac{n_q}{n_{q-1}} = \frac{n_e v_e \sigma_i(q-1,q)}{n_0 v \sigma_c(q,q-1)} = \frac{(J / e) \sigma_i(q-1,q)}{n_0 v \sigma_c(q,q-1)}$

ここで、Je は電子ビームの電流密度、ve,v は電子 ビームの速度と衝突のときの相対速度、ne,no は電 子ビームと残留ガスの数密度である。この関係よ り、EBIT での多価イオン生成において、大きな J と小さな no、すなわち高密度の電子ビームと超高 真空が必要であることがわかる。

4. 小型 EBIT の製作

我々はこれまで電気通信大学レーザー新世代研 究センターの Tokyo EBIT[6]を用いて鉄多価イ オンの分光測定を行なってきた。しかしながら、 Tokyo EBIT は最大 300keV もの高エネルギー電 子ビームによって、U⁹²⁺のような高電離重元素イ オンを生成することを目的に設計されているため、 本研究で目的としている10価程度の鉄多価イオン の生成に適した 1keV 以下の電子ビームでの運転 は不適で、統計的な測定を行なう実験は困難であ った。また、装置の大きさは 5m 程と大きく、更 には運転の際に高価な液体へリウムを使用するな ど、本研究には不都合な点がいくつかあった。そ のため今回、10 価程度の鉄多価イオンの EUV 分 光に最適な小型 EBIT を製作した。

本装置は、設計仕様を最大電子ビームエネルギ ー:1keV、同電流:10mA、最大軸上磁場:0.2 T とした。1keV の電子ビームでは Fe¹⁶⁺までの鉄多 価イオンが生成可能である。低エネルギー、低磁 場仕様のため全長で約 50cm 程と、装置全体の大 幅な小型化が可能となった。図 3 に小型 EBIT の 概略図を示す。また、表 1 に小型 EBIT の設計仕 様を示す。

4.1 電子銃

電子銃はTokyo-EBITと同じ電子銃を使用した。 Pierce型で直径3mmの凹面カソード、アノード、 フォーカス、スノート、またそれらを囲むように 配置される磁気シールドで形成されている。

電子銃を空間電荷制限領域で動作させたい場合、 得られる電子ビーム電流値 I [A] と、陽極電圧 V_a [V] との間には、次式が成立する。

$P = I / V_a^{3/2}$ [A/V_a^{3/2}]

この式より、Vaを 1000V 程度にすると 10mA 以上 の電流値が得られる。EBIT の電子ビームは完全な 層流が理想とされるため、TRICOMP と呼ばれる 市販のソフト[7]を用いて電子ビームの空間電荷を 考慮したシミュレーションを繰り返し、電極電位 と軸上磁場分布の最適化を行った。図 4 に軌道シ



図 3. 小型 EBIT の概略図 (a)電子銃、(b)イオン化領域、(c)コイル (d)電子コレクター、(e)液体窒素容器 (f)吊り下げ機構、(g)電流導入端子

	小型 EBIT	Tokyo-EBIT
装置サイズ	~ 0.6m	~ 5m
最大電子ビームエネルギー	1keV	300keV
最大電子ビーム電流	~ 10mA	330mA
電子銃パービアンス	$0.4 \mu A/V_{a^{3/2}}$	$0.4 \mu A/V_{a^{3/2}}$
最大電流密度	32A/cm	10000A/cm
最大磁場強度	0.2 T	~ 4.5 T
イオントラップ領域長さ	2cm	3cm

表 1. 小型 EBIT の設計仕様と Tokyo-EBIT との比較

ミュレーションの結果を示す。以下に、電子銃を 構成する各電極の詳細を述べる。

4.1.1 カソード

多孔質タングステンの表面に BaO,CaO,Al₂O₃ を含浸し仕事関数を減少させており、動作温度を 減少させるためにオスミウムなどをカソード表面 に塗っている。カソード自体は数Wのヒーター電 力で最大電流 300mA 以上の電子放出能力を持つ。

4.1.2 アノード

カソードに対して正の電位を印加することによ り電子をカソード表面から引き出す働きをする。

4.1.3 フォーカス

カソードとアノードの間に位置し、カソード~ アノード間に同心球の電場を作るための補修電極 で、ビーム電流や条件に応じてカソードに対して 0V~-数10Vの負電位を印加する。

4.1.4 スノート

アノードを出た電子ビームはスノートによりさ らに加速される。また、電子ビームの軌道を修正 する働きをする。

4.1.4 磁気シールド

スノートとアノードとの間に位置し、超伝導コ イルからの磁場を遮蔽する働きをする。材質は電 磁軟鉄(SUYBO)を使用している。磁気特性を満た すために 850 で 3 時間焼鈍した後、ニッケルメ ッキを施した。



4.1 ドリフトチューブ(DT)

電子ビームはカソード~DT 間の電位差で加速 される。本装置では、DTの周りに配置する接地電 位の超伝導コイル、液体窒素容器との放電などを 防ぐために DT2 を接地電位に固定している。 また、DT1,DT3 に中央の DT2 に対して数 10V 程 度の正の電位を印加することにより、電子ビーム 軸方向に多価イオンをトラップすることができる。 4.3 電子ビームコレクター

イオン化領域を通り抜けた電子ビームは、電子 コレクターで全て回収されなければならない。 Tokyo-EBIT では 300keV の電子ビームを回収す るためドリフトチューブ~電子コレクター間で 3keV 程度まで減速して回収しているが、小型 EBIT の電子ビームは 1keV: 10mA であるため、 減速せずに電子コレクターで回収している。しか し、ビームを回収することで少なからず発熱(10W 程度)が起きるため、熱伝導性に優れた絶縁碍子を 通して液体窒素容器の熱で電子銃全体の冷却を行 っている。図 5 に電子ビームコレクター領域での 軌道シミュレーションの結果を示す。以下に、電 子コレクターを構成する各電極の詳細を述べる。

4.3.1 コレクター電極

コレクター電極はテーパー型をしており、DT2 と 同じ接地電位に設定される。

4.3.2 磁気シールド

コレクター電極と同じく接地電位に設定される。 コレクター部での磁場を遮蔽し、電子ビーム自身 の空間電荷によって発散させる働きをする。

4.3.3 エクストラクター電極

コレクター電極よりさらに - 100V 程度の負電位 を印加することで電子軌道を修正して全ての電子 をコレクター電極で回収できるようにしている。





4.4 高温超伝導コイル

DT の外周を同芯上に取り囲む液体窒素容器の中 に収められ、超伝導状態で動作するヘルムホルツ 型コイルである。高温超伝導線材は住友電工社製 のビスマス系超伝導線(DI-BSCCO)を使用した。図 6 に高温超伝導コイル、表 2 に設計仕様、図 7 に DT 中心領域での磁場分布を示す。



図 6. 高温超伝導コイル

中心磁場	0.2 T	
磁場均一度	0.01 T	
電流	50 A	
起電力	8600 AT	
コイル巻き数	172 TURNS	
電流密度	42.5 A/mm ²	
断面形状	8.4mm ² ×18.9mm ² (×2個)	
内径	50 mm	
外径	68.9 mm	
コイル間隔	36 mm	





4.5 液体窒素容器、真空容器

液体窒素容器は内部に超伝導コイルを含んでお り、コイルを液体窒素温度(77K)まで冷やす他に、 イオン化領域での真空度を向上させるクライオポ ンプの働きをする。容器の容量は約 3.2 程で、一 度の充填で約6時間程度の連続運転が可能である。 真空容器は、EBIT全体を構成する真空容器で、内 部に電子銃と液体窒素容器を収納する。多価イオ ンからの発光を観測するため、ドリフトチューブ 中央の高さに 6 個の観測ポートがあり、分光測定 時の発光観測用ポートの他に、真空イオンゲージ、 四重極型質量分析器、ガス導入などの取り付けに 使用している。チェンバー全体はベーキングを行 い、ターボ分子ポンプとスクロールポンプによる 排気によって真空度 1×10⁻⁷Pa 程度が得られてい る。

5. 小型 EBIT の評価

小型 EBIT 製作の目的は、極端紫外線領域にお いて10価程度の鉄多価イオンからの発光の様子を 詳細に調べ、鉄多価イオンの基礎原子データを収 集し、モデル計算の精度を向上させることである。 製作した小型 EBIT で目的とする多価イオンが生 成できるかどうかを試験するため、電子ビーム通 過実験、電子ビーム径の測定を行い、研究室に既 存の可視分光器により多価イオンからの発光を観 測した。

5.1 電子ビーム通過実験

製作した小型 EBIT で実際に電子ビームを出し、 最大電子ビームエネルギー、最大電子電流を測定 した。試験運転にて、1keV:10mA,800eV:10mA, 500eV:5mA,200eV:8mAの電子ビームの運転 に成功した。この運転により、設計仕様であった 1keV,10mAの電子ビームが運転可能であること を確認した。

5.2 電子ビーム径の測定

EBIT において高効率で電離を行うには、電子ビ ームを磁場により細く圧縮し高密度の電子ビーム を作ることが重要である。よって、電子ビーム径 は EBIT にとって重要なパラメータであるため、 電子ビーム径を測定する必要がある。測定の結果、 電子ビームの直径は約 0.2mm であり、製作した小 型 EBIT の電子ビームの電流密度は約 32 A/cm²と 見積もることができる。

5.3 多価イオンの可視分光

過去に観測例が報告されている発光線を測定対 象とし、電子ビームエネルギー(E_e)に対する多価イ オンの発光スペクトルの依存性を調べ、報告例と 比較し考察を行った。図9に、実験の配置図を示 す。



図8. 可視分光測定の配置図

まず初めに、比較的取り扱いの容易な希ガス元 素(Kr)による測定を行い、その後に鉄を用いて測定 した。希ガス元素は観測ポートに取り付けたガス 導入から導入し、鉄は有機金属化合物のフェロセ ン(C10H10Fe)を蒸気圧でガス導入まで送り、ガス導 入を通して EBIT チェンバー内に導入している。 また、波長の較正は He,Ne,Ar,Kr の標準ランプか ら観測されるスペクトルを用いて行った。

図 10 に Fe¹³⁺の(3s²2p ²P_{1/2} – ²P_{3/2})の遷移による 530.2nm の発光スペクトルを示す。電子ビームエ ネルギー(Ee)は 300eV ~ 500eV、電子電流は 10mA、 測定時間は 60min で行った。

Fe¹³⁺の生成に必要な電子ビームエネルギー、す なわち Fe¹²⁺のイオン化エネルギーは約 372eV で あり、この閾値を超えると発光線が突然現れるこ とから、この同定が正しいことが確かめられる。 また、電子ビームエネルギーの変化に依存して発 光の様子が変わることが確認できる。Fe¹³⁺は太陽 コロナに存在する多価イオンであり、この発光線 はコロナの中で最も強いラインの1つである。



図 9. Fe¹³⁺の発光スペクトル

6. まとめ

10 価程度の鉄多価イオン分光用の小型イオン源 を設計・製作した。設計仕様を電子ビームエネル ギー:1keV,同電流:10mA,最大軸上磁場:0.2 Tと することで、EBIT 全体の大幅な小型化が可能とな った。また、製作した小型 EBIT での可視分光に より、電子ビームの適宜調整によって Fe¹³⁺などの 目的の多価イオンを生成し、1 時間以上の長時間で トラップできることを確認した。

今後は、極端紫外線領域での分光測定を行い、 10 価程度の鉄多価イオンの基礎原子データの構築 を行う。

[1] http://hinode.nao.ac.jp/index.shtml

[2] http://hinode.nao.ac.jp/panf/make_corona.shtml

- [3]M.A.Levine, R.E.Marss, J.R.Henderson, D.A.Knapp, a nd M.B.Schneider, Physica Scripta T22, 157
- [4] H. Tawara and H. Imamura, in Workshop on EBIS and Related Topics, edited by B. Wolf and H. Klein, GSI, Darmstadt, 1977, p. 77.
- [5] Penetrante,B.M.,Bardsley,J.N.,DeWitt,D.,Clark, M., Schneider,D., Phys.Rev.A43, 4861-4872 (1991)
 [6]中村信行,大谷俊介,日本物理学会誌 52 巻,p.919
 [7] http://www.fieldp.com/index.html